

















各种数码成像设备

(数码照相机、摄像机、摄像头、复印机、传真机等)



胶卷时代











1975年,柯达公司用CCD制造了可以操作的电子相机。相机从此进入电子数码时代。



1975年的10月7日,世界上第一张数字照片诞生。







2009年,柯达公司宣布柯达克罗姆反转片(Kodak Chrome)正式停产。胶卷时代过去了。

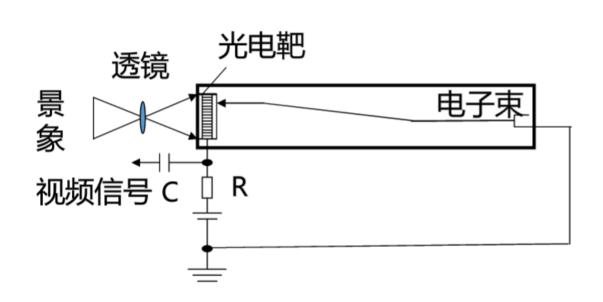
2012年1月19日,柯达正式申请破产。柯达,一个拥有一百多年历史,称霸全球的胶卷业巨头,一个与摄影艺术共同成长起来的影像器材帝国,在二十一世纪数码大风暴的侵袭中,轰然倒塌。



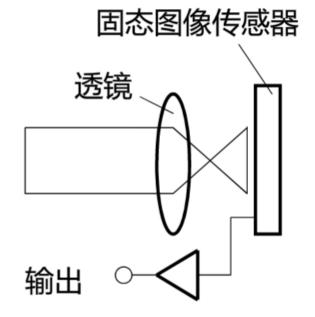
图像传感器

图像传感器是指利用光电器件的光电转换功能,将其感光面上的光像转换为与光像成相应比例的电信号"图像"的一种功能器件。





光导摄像管



固态图像传感器







CCD (Charge Coupled Device)全称电荷耦合器件,是1970年贝尔实验室的威拉德·博伊尔(Willard S. Boyle)和乔治·史密斯(George E. Smith)发明的。

40年后,随着影像传感器逐渐发展成为一个年出货量达13亿颗的庞大市场,两位技术先锋也在2009年获诺贝尔物理奖。

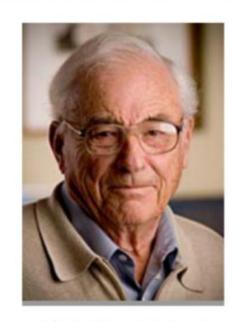




2009诺贝尔物理学奖获得者



高锟 (Charles K. Kao)



威拉德•博伊尔



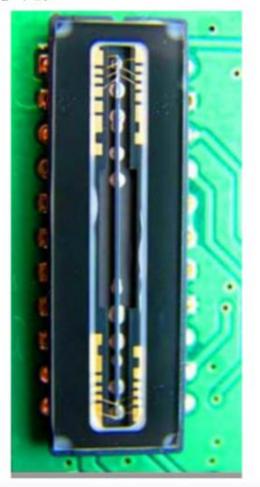
乔治·史密斯 (Willard S. Boyle) (George E. Smith)



线阵CCD外形

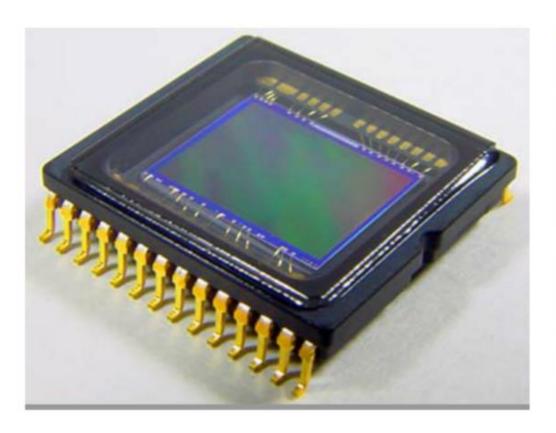


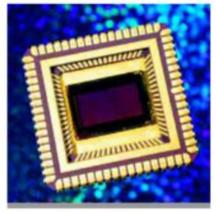


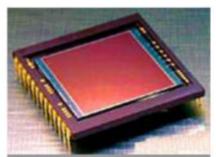




面阵CCD外形









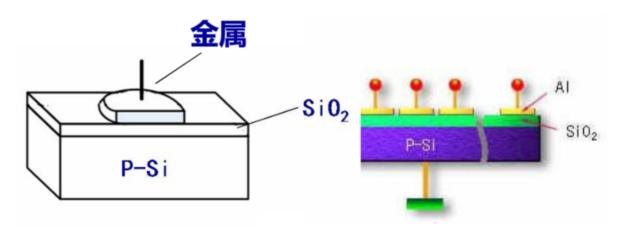
- > CCD的基本功能是电荷的产生、存储、转移和输出。
- CCD的最基本单元就是MOS电容器。



MOS电容器

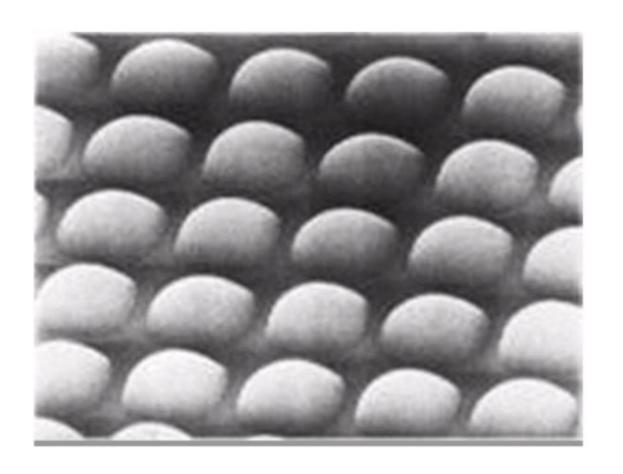
MOS — metal oxide semiconductor.

Metal
Oxide
Semiconductor



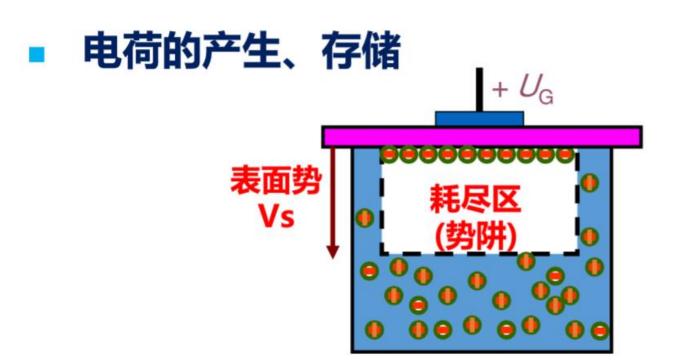
- CCD的光敏单元是在P型(或N型)硅衬底上生长一层厚约120nm的 氧化物SiO₂层。
- 再在SiO2层上依次沉积金属或掺杂多晶硅电极。





显微镜下的MOS电容

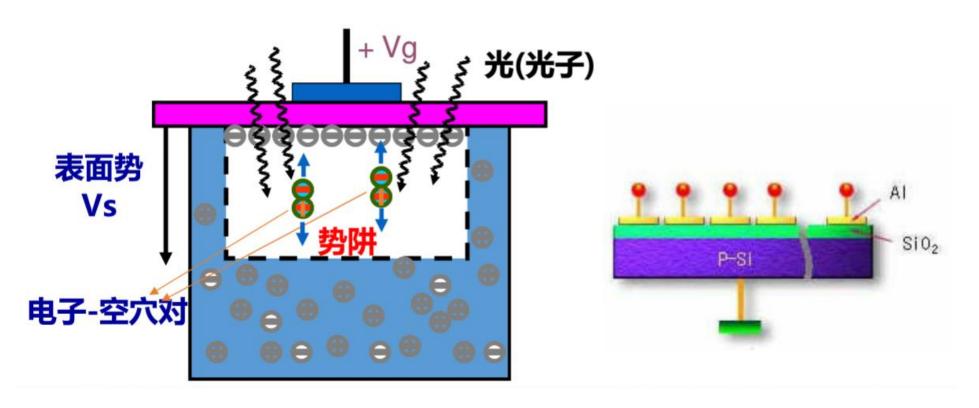




向SiO₂表面电极加正偏压,P型硅中的多数载流子(空穴)受到排斥,半导体内的少数载流子(电子)吸引到P-Si界面处来,形成一个带负电荷的耗尽区(表面势阱)。



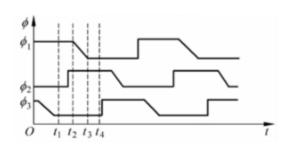
光电转换的实现

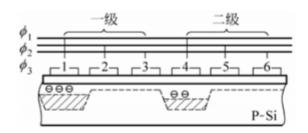




电荷转移

把MOS光敏元的电极每3个分成一组,依次在其上施加三个相位不同的时钟脉冲(又称控制脉冲或驱动脉冲) ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_3 。 ϕ_1 驱动电极1、4, ϕ_2 驱动电极2、5, ϕ_3 驱动电极3、6。





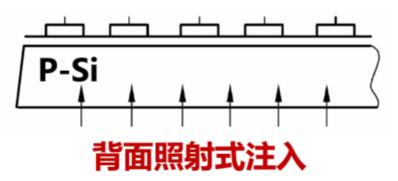
三相时钟脉冲波形



电荷的注入

1)光信号注入

当光信号照射到CCD衬底硅片上时,在栅极附近的耗尽区吸收光子产生电子-空穴对。这时在栅极电压的作用下,多数载流子(空穴)将流入衬底,而少数载流子(电子)则被收集在势阱中,形成与光强成正比的信号电荷存储起来。

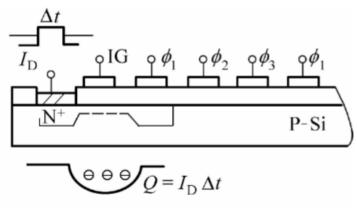




电荷的注入

2) 电信号注入

二极管位于输入栅衬底下,当输入栅加上宽度为△t的正脉冲,输入二极管PN结的少数载流子通过输入栅下的沟道注入ፉ电极下的势阱中。



电压信号注入

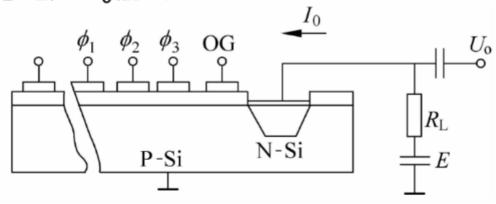
注入电荷量

$$Q = I_{\rm D} \Delta t$$



■ 电荷的输出

OG为输出栅,当加上反相偏压时,转移到终端的电荷在时钟脉冲作用下移向输出二极管,被二极管的PN结所收集,在负载 R_L上形成脉冲电流 G₂。输出脉冲电流的大小与信号电荷的大小成正比,并通过负载电阻转换为信号电压 U₃输出。

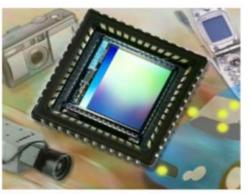




CCD图像传感器从结构上可分为两类:

- ▶一类是用于获取线图像的线阵型CCD图像传感器,主要用于产品外部尺寸非接触测量、产品表面质量评定、传真和光学文字识别等方面;
- ▶另一类用于获取面图像的<mark>面阵型CCD图像传感器</mark>,主要用于摄像领域。





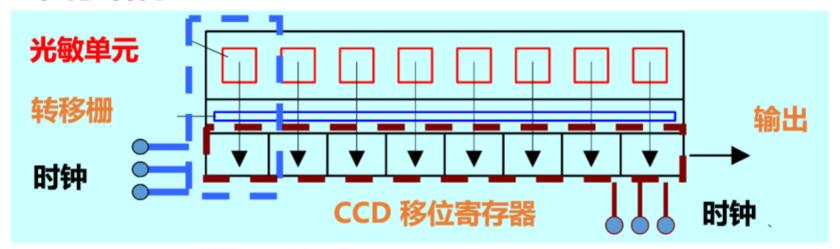


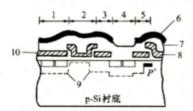




■ 线型CCD图像传感器

1) 单行结构





高灵敏度线型传感器截面构造

1-CCD; 2-转移控制栅; 3-积蓄电极;

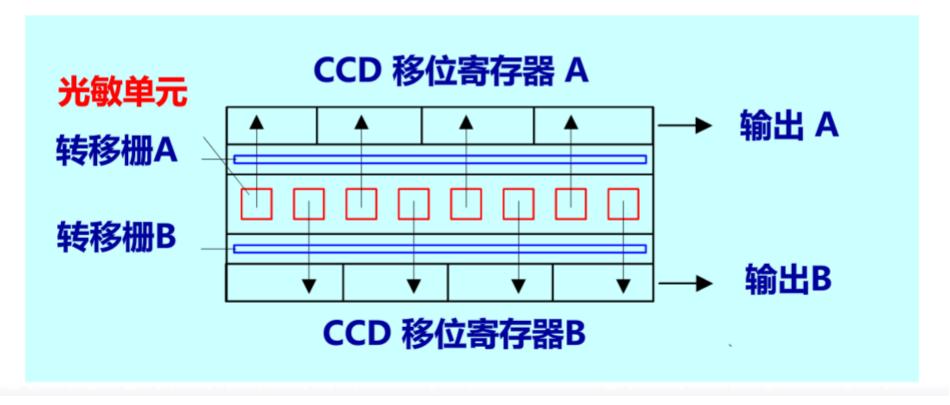
4-PD; 5-积蓄电极; 6-光屏蔽(AI 膜);

7-SiO2 膜; 8-第二层多晶硅; 9-耗尽层;

10-第一层多晶硅。

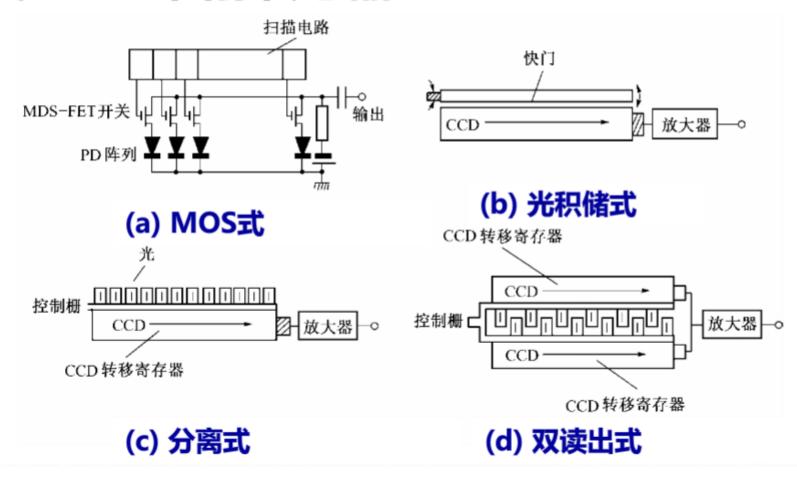


- 线型CCD图像传感器
- 2) 并行结构





■ 线型CCD图像传感器

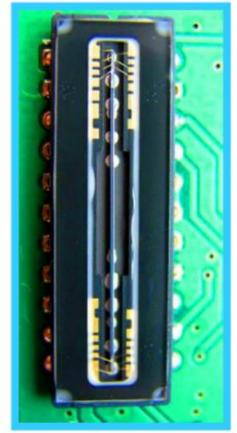




线型CCD图像传感器





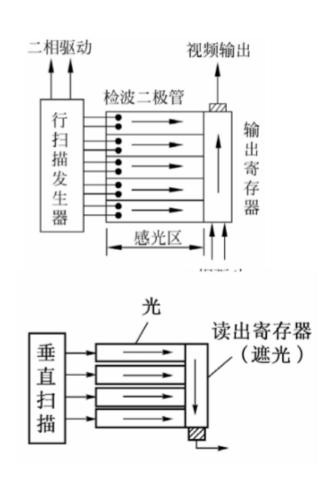




■ 面阵型CCD图像传感器

1)线转移式

- 由行扫描电路、垂直输出寄存器、感光区和输出二极管组成。
- 行扫描电路将光敏元件内的信息转移到水平(行)方向上,由垂直方向的寄存器将信息转移到输出二极管。
- 输出信号由信号处理电路转换为视频图像信号。

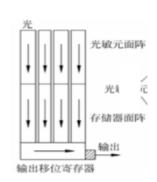




■ 面阵型CCD图像传感器

2)帧转移式

- 构成:感光区、暂存区、读出寄存器
- 电荷的转移过程:
 - (1) 感光区的光生信号电荷送到带有光屏蔽的暂存区
 - A、感光区积累起一帧电荷包阵列后,感光区和暂存区施加频率为fcv1的驱动时钟;
 - B、一个周期使电荷包向下移动一行;
 - C、经过M个周期(M行),这帧图像转移到暂存区。
 - (2) 感光区进入下一个积分周期
 - (3) 暂存区电荷在频率为fcv2驱动下向水平寄存器转移
 - A、底部N个电荷包先转移至水平读出寄存器;
 - B、这行电荷包在水平寄存器中以频率为f_{CH}的时钟驱动,转移至输出端,形成视频信号;
 - C、重复A、B, 依次输出(M行)。

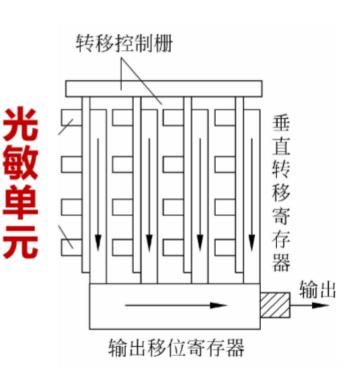




■ 面阵型CCD图像传感器

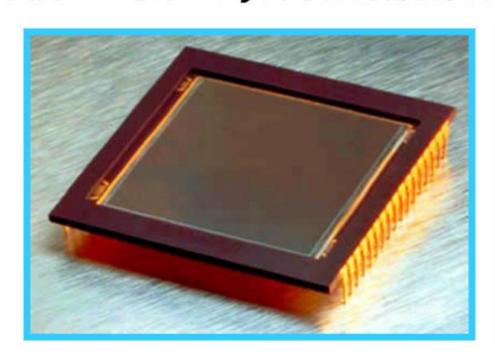
3)行间转移式

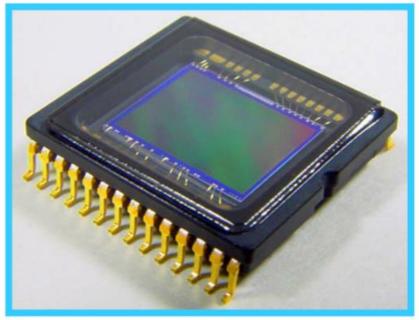
- 光敏单元与垂直转移寄存器交替排列。 在光积分期间,光生电荷存储在感光区 光敏单元的势阱里。
- 当光积分时间结束,转移栅的电位由低变高,信号电荷进入垂直转移寄存器中。
- 随后,一次一行地移动到输出移位寄存器中,然后移位到输出器件,在输出端得到与光学图像对应的一行行视频信号。





面阵CCD能在x、y两个方向都能实现电子自扫描,可以获得二维图像。







CCD靶面尺寸

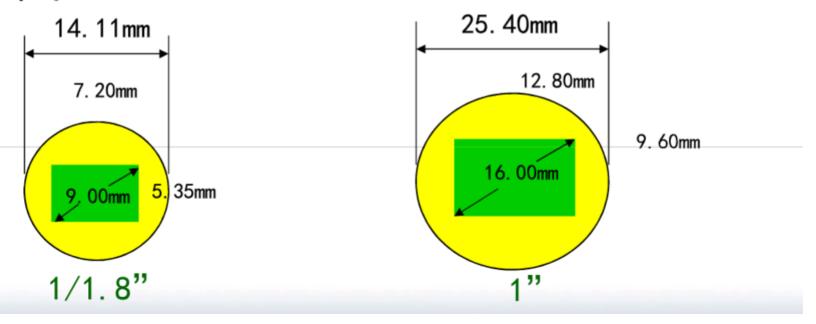
所谓 "CCD靶面英寸" 是CCD感光列阵的大小,常见的有:1/1.8"、1/2"、1/3"、1/4"等。

例如,型号为"1/1.8"的CCD,表示其成像面积与一根直径为1/1.8"的光导摄像管的成像靶面面积近似。



CCD靶面尺寸

光导摄像管的直径与CCD成像靶面面积之间没有固定的换算公式,从实际情况来说,CCD成像靶面的对角线长度大约相当于光导摄像管直径长度的2/3。





■ CCD靶面尺寸

要提高影像质量必须增加CCD的像素;

若在CCD靶面尺寸一定的情况下,增加像素就得缩小像素点的面积;像素点的面积越小(大),其感光性能越低(高),信噪比越低(高),动态范围越窄(宽);

所以,如果不增加CCD面积而一味地提高像素;只会引起图像质量的 恶化。

大尺寸CCD加工制造比较困难,成品率也比较低,成本高。



■ 电荷转移效率

当电荷一次转移之后,到达下一个势阱中的电荷与原来势阱中的电荷 之比称为电荷转移效率。

好的CCD具有极高的电荷转移效率,一般可达0.999995。

例如,一个有2048像数的CCD,其信号电荷的总的电荷转移效率为 0.99995²⁰⁴⁸ = 0.9898,损失率只有约0.1%。



量子效率

量子效率是用来定义光敏器件,例如底片、感光耦合元件将其受光表面接收到的光子转换为电子-空穴对的百分比例。

量子效率越高,器件的灵敏度越高。由于光子的能量与波长的倒数成比例,量子效率的测量通常是在一段波长范围内进行。普通胶片的的量子效率通常少于10%,而CCD在某些波长位置具有超过90%的效率。



暗电流

在无光照的情况下,图像传感器能产生的输出噪声电流称为暗电流。此电流越小,噪声干扰越小,信噪比越高。

暗电流时是由于热激励产生的电子-空穴对。



■ 动态范围

动态范围 = 饱和曝光量 / 噪声曝光量(暗电流)

动态范围表示图像中所包含的从"最暗"至"最亮"的范围。

动态范围越大,所能表现的层次越丰富,所包含的色彩空间也越广。

